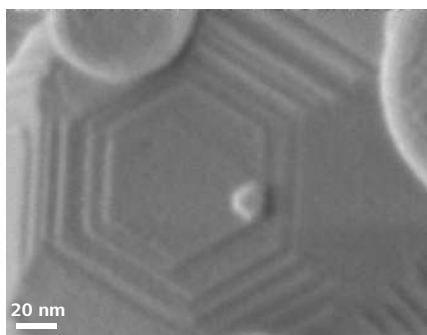




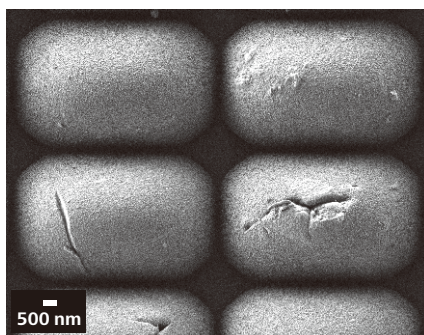
ZEISS Gemini 技術をより多くのSEMユーザーに!

高画質イメージングと高度な解析を実現する電界放出型SEM

ZEISS Sigma Family



アルミナ粒子のステップ観察、加速電圧：500 V
サンプルバイアス無し加速電圧 500 V にて 3 nm の
テラス構造が観察可能、Inlens SE 像



CCD レンズの最表面観察、加速電圧：300 V
サンプルバイアス無し加速電圧 300 V にてレンズ表
面の微小凹凸を観察可能、ET-SE 像



1 kV以下で強みを発揮 優れた解像度と 最適なコントラスト

イメージングと解析性能の鍵となるのは電子光学カラムです。ZEISS Gemini 1 電子光学系を搭載した Sigma は、特に低加速電圧において、あらゆる試料に対して優れた分解能を発揮します。低加速電圧での分解能は、Sigma 360 で 1.1 nm @ 1 kV、Sigma 560 では 1.0 nm @ 1 kV、1.5 nm @ 500 V を実現しています。

直感的なイメージングワークフロー セットアップからAIによる 結果取得まで

初心者でも専門知識に基づいたデータ取得が可能です。使いやすく覚えやすいワークフローにより、ナビゲーションから後処理までの各ステップが効率化されます。機械学習による画像セグメンテーションが可能な AI Toolkit や、スムーズなマルチモーダル実験を可能にする Connect Toolkit など、各種オプション機能により、解析のスループットが向上します。

困難な条件でもVPイメージングを実現 解析・イメージング用 NanoVP liteモード

ZEISS 独自の低真空モード NanoVP lite と新しい検出器が、5 kV 以下においても非導電性試料からの高品質データの取得を可能にします。5 つの環状セグメントを持つ aBSD 検出器や次世代 C2D (カスケード電流検出器) などの新しい検出器を使用することで、低加速電圧でも優れたイメージングが可能です。

ZEISS Sigma 360

Sigma 360 ショットキー電界放出型走査電子顕微鏡
インレンズ二次電子検出器、ET検出器、カラーCCDチャンバースコープ
(仕様の詳細は弊社担当者にお問い合わせください。)

キャンペーン価格(税抜) **33,000,000 円～**

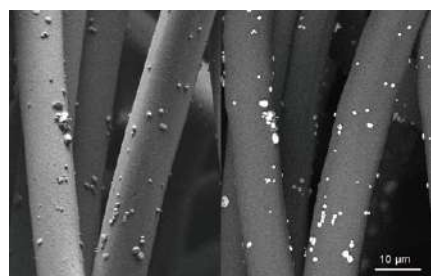


Seeing beyond

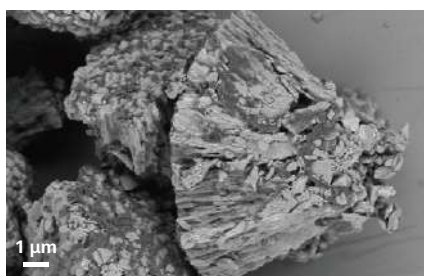


多様な試料で優れたイメージングを可能にするZEISS Gemini技術

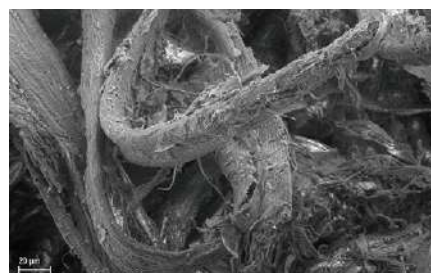
ZEISSのGemini 1 カラムはSigmaの性能の鍵で、優れた分解能、高い検出効率、最高の操作性を提供します。Gemini 対物レンズの設計は、静電場と磁場を組み合わせることで、試料に与える磁場の影響を最小限に抑えながら、光学性能を最大限に高めます。Gemini 1 カラムの高度な特長（電子光学設計、Inlens 検出、ビームブースター）は、Sigma Family に共通するものです。



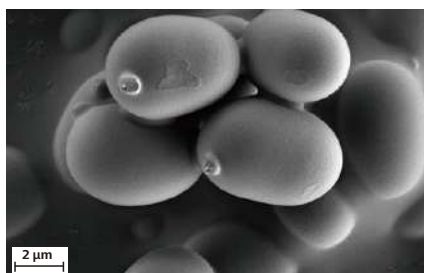
銀ナノ粒子付着ファイバー、加速電圧：1 kV
(左) Inlens Duo SE (右) Inlens Duo BSE



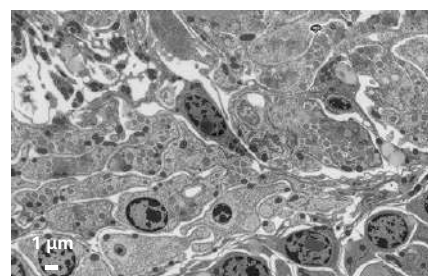
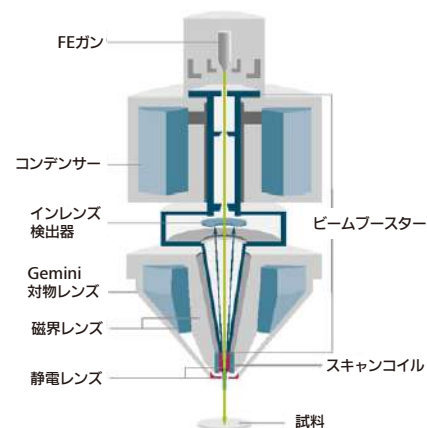
LIB 正極材 NMC 粒子のバインダー観察、加速電圧：2 kV、aBSD 像（反射電子）



セルロースナノファイバー、加速電圧：8 kV、チャンバ真空度 40 Pa、C2D 像（無コーティング）



キノコの胞子、加速電圧：1 kV（高真空）



海産無脊椎動物の微細構造、加速電圧：1 kV、Sense BSD 像
ご提供：Anna Seybold and Harald Hausen, Sars Centre for Marine Molecular Biology, University of Bergen, Norway

フレキシブルな拡張性でエントリー機から最先端アプリケーションまで対応

標準の Inlens SE、ETSE 検出器に加えて、各種反射電子検出器や STEM、CL 検出器などのイメージング用検出器、EDS、EBSD、WDS 検出器を搭載可能です。また、共焦点ラマンイメージングとの組み合わせ (RISE) や加熱・引張の in situ 実験、シリアルブロックフェース (SBF) イメージングといった高度なイメージングシステムへと拡張することも可能です。

ZEISS Sigma 360

分解能 *	@ 30 kV (STEM)	1.0 nm
	@ 15 kV /DCV**	0.9 nm / 0.7 nm
	@ 1 kV /DCV**	1.3 nm / 1.1 nm
加速電圧	0.02 – 30 kV	
倍 率	10x – 1,000,000x	
プローブ電流	3 pA – 20 nA (100 nA: オプション)	

* 最適動作距離：設置時の検収試験において、1 kV および 15 kV で分解能の実証を実施（高真空、DCV なし）

** デコンボリューション使用時の分解能



製品の詳細情報はこちら！



Carl Zeiss 株式会社
ZEISS Research Microscopy Solutions
info.microscopy.jp@zeiss.com



Seeing beyond